

Реєстраційна картка ДіР

I. Загальні відомості

Державний реєстраційний номер: 0126U004633

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 08-09-2026



II. Підстава для проведення робіт

Підстава для проведення ДіР: 34 - Договір (замовлення) з міністерством, іншим центральним органом виконавчої влади, академією наук (головним розпорядником бюджетних коштів на проведення ДіР)

Напрям фінансування: 2.1 - Фундаментальні дослідження ()

Джерела фінансування

7713 - Кошти загального фонду державного бюджету

Код програмної класифікації видатків і кредитування (КПКВК): 2201380

У тому числі по роках:	
2026	185.000 тис. грн.
Загальний обсяг фінансування: 185.000 тис. грн.	

III. Відомості про замовника ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Міністерство освіти і науки України

Код за ЄДРПОУ: 38621185

Місцезнаходження: проспект Берестейський, Київ, 01135, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Кабінет Міністрів України

Ідентифікатор ROR:

Розмір організації:

Телефон: 380444813221

IV. Відомості про виконавця ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Інститут фізики напівпровідників імені В. Є. Лашкарьова Національної академії наук України

Код за ЄДРПОУ: 05416952

Місцезнаходження: проспект Науки, Київ, 03028, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Національна академія наук України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: 380445254020, 380445258342

V. Відомості про співвиконавця ДіР

VI. Відомості про ДіР

Назва роботи українською:

Гетероепітаксія методом MOCVD та аналіз дефектів у плівках Ga₂O₃ для передової сенсорики в діапазоні далекого УФ-випромінювання

Назва роботи англійською:

MOCVD heteroepitaxy and defect analysis of Ga₂O₃ films for advanced deep UV sensing

Мета роботи українською:

Встановити взаємозв'язок між умовами вирощування (вид прекурсорів, технологічні параметри вирощування, характеристики підкладки) та структурними властивостями, морфологією і складом гетероепітаксійних шарів n-Ga₂O₃ для детекторів ультрафіолетового випромінювання далекого діапазону.

Мета роботи англійською:

To establish relationship between the growth conditions (precursor types, growth parameters, substrate characteristics) and structural properties, morphology, and composition of n-Ga₂O₃ heteroepitaxial layers for far-ultraviolet detectors.

Пріоритетний напрям розвитку науки і техніки: Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави

Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:

Вид роботи: Фундаментальні наукові дослідження

Очікувані результати: Технології; Матеріали; Методи, теорії, гіпотези

Галузь застосування: широкозонні напівпровідники, епітаксійні технології, фізика тонких плівок, оптоелектроніка

Керівники роботи

Власне Прізвище Ім'я По-батькові: Саріков Андрій Вікторович

Науковий ступінь:

Вчене звання:

Ідентифікатор ORCID ID:

Додаткова інформація:

VII. Етапи виконання ДіР

Номер етапу: 1

Назва етапу: Технологія тонких плівок Ga₂O₃

Початок етапу: 08.2026

Закінчення етапу: 12.2026

Вид звітнього документа: Проміжний звіт

VIII. Індекс УДК, тематичні рубрики НТІ

Індекс УДК: 621.38.049.77, 621.315.592, 537-311.322

Коди тематичних рубрик: 47.33.33, 47.09.29, 29.19.31

IX. Заключні відомості

Керівник юридичної особи

Мельник Віктор Павлович

д. ф.-м. н., професор

**Відповідальний за підготовку
облікових документів**

Редько Роман Анатолійович

Телефон

+380506840721

Реєстратор

Юрченко Тетяна Анатоліївна

**Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є
відповідальним за реєстрацію наукової
діяльності**



Юрченко Тетяна Анатоліївна